

СОДЕРЖАНИЕ

Том 48, номер 6, 2019

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- Создание и развитие ионно-лучевых технологий
Ю. П. Маишев 403
- Параметры плазмы и механизмы травления кремния в смеси $CF_4 + CHF_3 + O_2$
А. М. Ефремов, Д. Б. Мурин, К.-Н. Kwon 421
-

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

- Моделирование влияния структуры межзеренной границы на эффективные заряды ионов в процессах электромиграции
Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев 430
- Моделирование сбора заряда с трека ионизирующей частицы в КМОП триггерных элементах повышенной сбоеустойчивости
В. Я. Стенин, Ю. В. Катунин 439
- Моделирование характеристик КМОП нанотранзистора с полностью охватывающим затвором и неравномерно легированной рабочей областью
Н. В. Масальский 452
-

ДИАГНОСТИКА

- Влияние давления кислорода на процесс окисления поверхности нитрида титана в плазме
В. М. Мордвицев, В. В. Наумов, С. Г. Симакин 460
-

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

- Оценка влияния электрического режима при облучении (активный и пассивный) на дозовую стойкость микросхем
О. А. Калашников 467
- Метод определения наиболее чувствительной области кристалла оптрона при дозовом воздействии с помощью рентгеновского источника
М. Е. Черняк, Е. В. Раннева, А. В. Уланова, А. Ю. Никифоров, А. И. Верижников, А. М. Цырлов, В. С. Федосов, А. Н. Шепанов, В. Д. Калашников, Д. О. Титовец 474
-
-